19p-P1-1

## 合成プロセスと分極処理による BaTiO3の圧電・強誘電特性と 結晶構造に与える影響

Effect of polarization and synthesis process on crystal structure and piezoelectric and

## ferroelectric properties of BaTiO<sub>3</sub>

## 東理大理工, <sup>0</sup>伊福 龍平, 石田 直哉, 北村 尚斗, 井手本 康

Tokyo Univ. of Science <sup>°</sup>Ryuhei Ifuku, Naoya Ishida, Naoto Kitamura, Yasushi Idemoto

## j7212612@ed.tus. ac.jp

1. 緒言 圧電セラミックスとして、優れた圧電・強誘電特性を持つチタン酸ジルコン酸鉛(PZT) が幅広く利用されている。しかし PZT の主成分である酸化鉛は、圧電材料の高機能化に重要な役 割を果たしているが、廃棄処理に関して環境問題の観点から規制されつつあり、圧電材料の完全 鉛フリー化が強く求められている。そこで本研究の目的として、代替無鉛材料の中で比較的良好 な圧電特性を示す BaTiO<sub>3</sub>(BT)に着目し、BT に関して圧電・強誘電特性の向上のために、固相法・ 錯体重合法・水熱合成法の3 つの合成プロセスを検討した。また各合成法の分極処理前後の強誘 電特性について検討した。さらに分極処理による圧電・強誘電特性の変化を検討するために分極 処理前後のそれぞれの試料で、粉末中性子回折、放射光 X 線回折を用いた結晶構造解析を行い、 結晶構造と強誘電特性との関係を検討することを目的とした。

2. 方法 BT 粉末を錯体重合法、水熱合成法、および従来法である固相法により作製した。緻密 な焼結体を得るために2段階焼結を試みた。各試料について粉末X線回折測定により相の同定及 び格子定数を算出した。また、アルキメデス法による密度測定とSEM による焼結体の表面と断面 の形態観察より焼結性について検討した。強誘電特性については、強誘電体テスター(TF2000)を 用い P-E ヒステリシスループを、また LCR メーターを用いて誘電率、誘電損失の温度依存、*T*。 を測定した。圧電特性は *d*<sub>33</sub>メーターを用いて測定した。さらに分極処理前後の各試料について、 TOF 型の粉末中性子回折測定(iMATERIA,J-PARC)、放射光X線測定(BL02B2,SPring-8)によって得 られたデータから、Rietveld 解析(Z-CODE,Rietan-FP)を行った。また、さらなる分極処理による影 響を詳細に調べるために、放射光X線解析による構造中の電子密度分布(MEM,Dysnomia)の解析を 行った。

3. 結果 実験室系の粉末 X 線回折測定により、各試料で単一相が得られた。また格子定数を算出 した結果、いずれの合成法においても c/a の値が 1 よりも大きく、正方晶(空間群: P4mm)に帰属 されることがわかった。SEM による焼結体の表面・断面形態を観察したところ、どの合成法にで も緻密で粒径が均一に制御されており(1.0~2.0  $\mu$ m)、水熱合成法、錯体重合法、固相法の順に粒径 が大きくなった。強誘電特性に関しては、P-E ヒステリシス測定より分極処理前の試料では、固 相法の試料が残留分極  $P_r$ 、抗電界  $E_c$ の値が最も大きくなった。分極処理を行うことで、各合成 法の試料で残留分極が大きくなった。これは分極処理を行うことで、ドメインの向きが揃うため  $P_r$ が大きくなったと考えられる。また比誘電率測定より、固相法、錯体重合法の試料で約 9000 の

大きな比誘電率が得られた。圧電測定は、固相法の試料で $d_{33}$ が 206pC/N を示した。粉末中性子回折では、正方晶モデル (P4mm)と立方晶モデル(Pm-3m)の 2 相モデルで解析を行った ところ良好なフィッティングが得られた。また、各合成法で 分極処理前よりも分極処理後の二次伸長 $\lambda$ 、結合角分散 $\sigma^2$ の 値が増加したことから、分極処理を行うことにより TiO<sub>6</sub> 八面 体の歪みが大きくなったことが明らかとなった。この八面体 の歪みの増加が、分極処理による  $P_r$ の増加に影響を及ぼして いる可能性があると考えられる。また放射光 X 線解析による 電子密度分布(MEM)の解析を行ったところ、分極処理を行う ことで Ti-O 間の電子密度が大きくなった(Fig.1)。



Ti-O1 間の電子密度分布